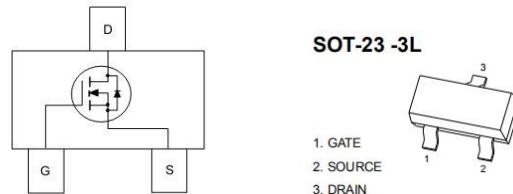


## FSS2302

### SOT-23-3L 場效應晶體管(SOT-23 -3LField Effect Transistors)



#### N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

#### ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rat 額定值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	20	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 10$	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	$I_D$	3	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脈沖	$I_{DM}$	12	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$	$P_D$	1000	mW
Junction 結溫	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 儲存溫度	$T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

#### ■ DEVICE MARKING 打標

FSS2302=A2SHB
---------------

## FSS2302

### ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ\text{C}$ )

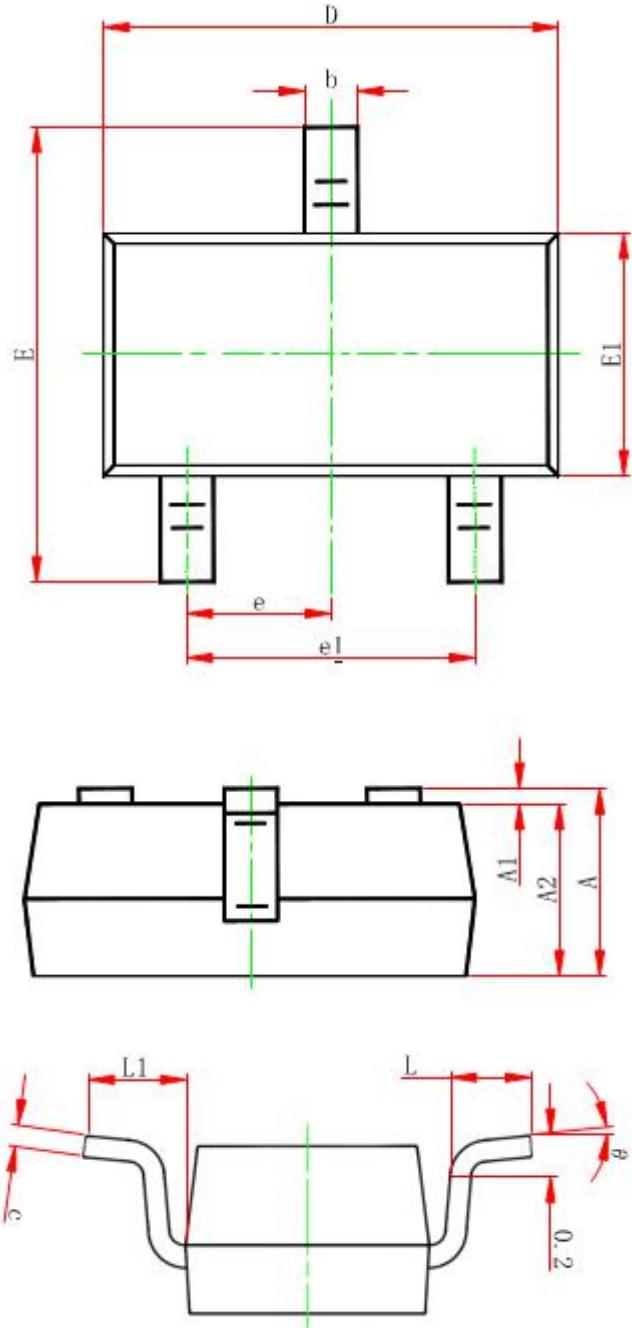
Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	BVDSS	20	22	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啟電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(\text{th})}$	0.5	0.75	1.5	V
Drain-Source On Voltage 漏極-源極導通電壓( $I_D=50\text{mA}, V_{GS}=5\text{V}$ ) ( $I_D=500\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$V_{DS(\text{ON})}$	—	—	0.375 3.75	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_S=0.75\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.2	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=16\text{V}$ ) ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=16\text{V}, T_A=55^\circ\text{C}$ )	IDSS	—	—	1 10	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 8\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻( $I_D=3.3\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$ ) ( $I_D=2\text{A}, V_{GS}=2.5\text{V}$ )	$R_{DS(\text{ON})}$	—	45 55	55 65	$m\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=6\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	550	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=6\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	170	pF
Turn-ON Time 开启時間 ( $V_{DS}=6\text{V}, I_D=1\text{A}, R_{GEN}=6\Omega$ )	$t_{(\text{on})}$	—	—	20	ns
Turn-OFF Time 关斷時間 ( $V_{DS}=6\text{V}, I_D=1\text{A}, R_{GEN}=6\Omega$ )	$t_{(\text{off})}$	—	—	65	ns

Pulse Width  $\leq 300\mu\text{s}$ ; Duty Cycle  $\leq 2.0\%$

## FS2302

### ■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代码	范围(单位: mm)
A	1.050~1.250
A1	0.000~0.100
A2	1.050~1.150
b	0.300~0.500
c	0.100~0.200
D	2.820~3.020
E1	1.500~1.700
E	2.650~2.950
e	0.950(BSC)
e 1	1.800~2.00
L	0.300~0.600
L1	0.600REF.
θ	0°~8°

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for MOSFET category:***

***Click to view products by FOSAN manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60\\_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)  
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T\)](#) [751625C](#) [BSC884N03MS G](#) [BSF024N03LT3 G](#)  
[PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-](#)  
[7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#)  
[SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#)  
[C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#)  
[IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)